	Формат Зана Поз.			Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание			
примен.					Документация					
Терв. г.					<u></u>					
1/6	A2			2016.ККП.402.007.001 E3	Схема електрична					
					принципова					
igdash	A4			2016.KKN.402.007.001 NE	Перелік елементів					
	A2			2016.ККП.402.007.003 СК	Складальне креслення					
i No					<u>Деталі</u>					
Справ	A1 ;		1	2016.ККП.402.007.002 Г.	Плата друкована	1				
					Інші вироби					
					Конденсатори					
D					MAL 215097 "Vishay"					
і дат					POSCAP D2E "Panasonic"					
Подп. ц			2		POSCAP D2E -H20-0,1mκΦ±10%	4	[2, [5-[			
16. Nº đườn.	╫		3		MAL 215097-25B-100mk Φ±20%		[1			
lo du			4		MAL215097-6,3B-220mkΦ±20%	2	<i>C3, C4</i>			
Инв. /			5		MAL 215097-25B-1000mkΦ±20%	1	<i>C8</i>			
UHB. Nº   VI					Мікросхеми					
Взам.										
7	1		6		78L05 STMicroelectronics	ł	DA1			
dam		_	7		LM2576S STMicroelectronics	<b>-</b>	DA2			
77. U	$\vdash$	十	8	<u> </u>	TS922 STMicroelectronics		DA3			
Подл. и с		M. /IU		Nº dokym.   lodn. ∐ama	016.ККП.402.007.01.U					
√о подл.		Разраб. Голояд Лит. Лист Пров. Василишин 1								
1B. Nº 1		Н.КОНПР.								
<u> </u>	911	7 <i>0.</i>		п использования Копир		.Терни пмат	опіль A4			

	Фармат	Зана	Поз.	Обозначение	,	Наименование	Кол.	Приме- чание
	$\phi$		9			MEGA8 "Atmel"	1	DD1
			10			Запобіжник	1	FU1
						SEF2.5 STMicroelectronics		
			11			Індикатор світловий	1	HG1
			77			BT-M322RO "Brightled"		7707
			12			<u> Дросель SND0705–102М</u>	1	<i>L1</i>
						"Anla Tech"		
						Резистори		
						RCO075 "Vishay"		
<b>5</b>			<i>13</i>			RC0075-0.125-1k0m±10%-A-B-A	3	R2, R4
Подп. и дата			כו			ACOUTS O.125 INOTIE 1070 A D A		R20
70 70			14		,	RC0075-0.125-3k0m±10%-A-B-A	1	R19
y dam			15			RC0075-0.125-10k0m±10%-A-B-A		R1,R15
10dn. u			16			RC0075-0.125-22k0m±10%-A-B-A	<b>-</b>	R5-R14
	_		<i>17</i>			RC0075-0.125-24k0m±10%-A-B-A DC007F_0.12F_20v0w.109<_A_B_A	<b>-</b>	R16-R1
, तेप्रठेत			18		/	RC0075-0.125-30k0m±10%-A-B-A	1	<i>R3</i>
HB. Nº			19			—————————————————————————————————————	2	SB1, SB.
No WHB. No QUBr.						IT-1102W "Switronik"		,
та Взам. инв						Діоди		
ממב			20			2MBR "National Rektifier"	1	VD1
$\sim$			21			MBR362 ON Semiconductor	<b>├</b> ं	VD2-VD
Nº nodr.   Nodr. u ō								
подл.	H							
NHB. Nº r					<u> 2016</u>		 7 <i>[ f</i>	AUL
		. /lui		№ докум.   Подп.   Дата   использования	Копирова		חאמח	A4 2

	Формат	она	Паз.	/	Э <i>бозначе</i>	PHUP		Haum	енования	<b>-</b>	Кол.	Приме- чание
	$\phi^0$	(,)	_						73 EMU			YQHUP
								, ,	יש בויום			
			22					AMPMODU	826629	-16	1	XS2
		4										
	H											
		1										
<i>Ілщены</i>		+										
рава защицены ла	$\parallel$											
Все прав и дата												
Россия. С												
робания", Н Цбл. — Г.	igert	+										
ы проект. Инв. № 6												
No M												
KKUH-A M. UHB.		-										
2015 ООО "АСКОН. а Взам. ини	H											
© 2015 Tama												
эрсия 1. и дс												
30 VI6 Учедная версия Nº подл.   Подп. и с	H	$\dashv$										
176 54 1071.	H	$\frac{1}{1}$										
N° NC			丁				2011		2007	0100	ו כי	/Jucin
KOMTAC VAHB. 1	Изм.	Nuc	ТП	№ докум. использования	Подп. Дал	<i>TIA</i>	2016 Kanupati	5.KK17.4 <i>0.</i>	Z.UU /		I <b>L F</b> PMAMT	3 A4